IF1322A, IN1322B

N-Channel Matched Dual Silicon Junction Field-Effect Transistor

- **Low Noise, High Gain Amplifier**
- **Differential Inputs**

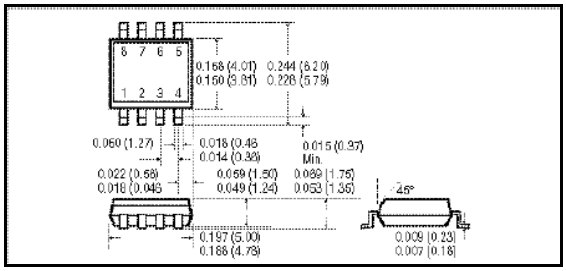
Absolute maximum ratings at $T_A = 25^oC$

Reverse Gate Source & Gate Drain Voltage	-20V
Continuous Forward Gate Current	10 mA
Continuous Device Power Dissipation	480mW
Power Derating	3.8 mW/^{o}C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C

At 25°C free air temperature

Static Electrical Characteristics		IF1322				Process NJ132L	
		Min	**Typ**	**Max**	**Unit**	**Test Conditions**	
Gate Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)GSS1}$ $V_{(BR)GSS2}$ $V_{(BR)GSS3}$	-20			V	I_G = -25 uA, V_{DS} = 0 V I_G = -3 uA, V_{DS} = 0 V I_G = -1 uA, V_{DS} = 0 V	
Fx	$\frac{V_{(BR)GSS1}}{V_{(BR)GSS2}}$	0.9		1.1			
Gate Reverse Current	I_{GSS}			-0.1	nA	V_{GS} = -10 V, V_{DS} = 0 V	
Gate Source Cutoff Voltage	$V_{GS(OFF)}$	-0.8		-1.5	V	V_{DS} = 10 V, I_D = 1 uA	
Drain Saturation Current (pulsed)	I_{DSS}	8		25	mA	V_{DS} = 10 V, V_{GS} = 0 V	
Gate Source Forward Voltage	V_{GSF}	0.3		1.0	V	V_{DS} = 0 V, I_G = - 1 mA V_{DS} = 0 V, I_G = - 1 uA	
Dynamic Electrical Characteristics							
Common-Source Forward Transconductance	g_{fs}	0.01			mS	V_{DS} = 5 V, V_{GS} = 0 V	1 kHz
Differential Gate Source Voltage- A	$\lvert V_{GS1}-V_{GS2} \rvert$			30	mV	V_{DS} = 5 V, I_D = 3 mA	
B	$\lvert V_{GS1}-V_{GS2} \rvert$			40	mV	V_{DS} = 5 V, I_D = 3 mA	
Equivalent Short Circuit Input Noise Voltage[1]	~e_N			4 2	nV/√Hz	V_{DS} = 5 V, I_D = 3 mA	100 hz 1 kHz
Equivalent Short Circuit Input Noise Current[1]	i_n			0.05	pA/√Hz	V_{DS} = 5 V, I_D = 3 mA	1 kHz

Note 1: Guaranteed but not tested.



Dimensions in Inches (mm)

SOIC-8: IF1322
1-G1, 2-D1, 3-S1, 4-G2,
5-G2, 6-D2, 7-S2, 8-G1

InterFET

715 N. Glenville Dr., Ste. 400
Richardson, TX 75081
(972) 238-9700 Fax (972) 238-5338
www.interfet.com

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.